

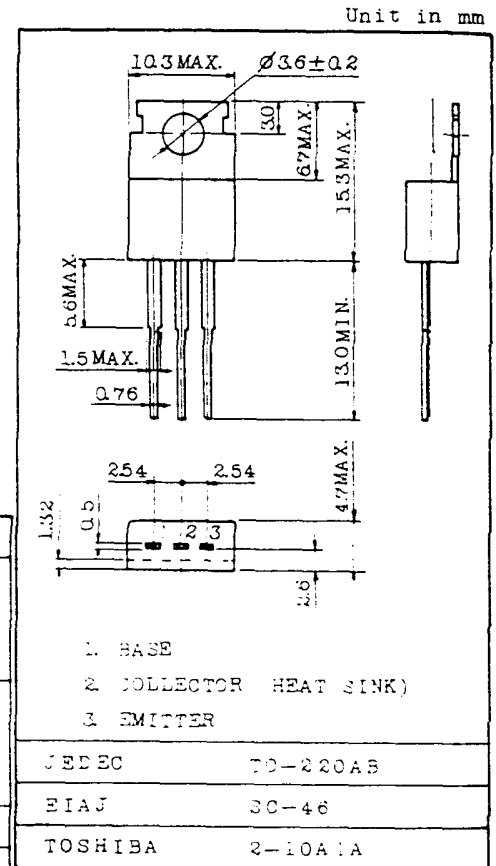
# 2SC2238・2SC2238A 2SC2238B

シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)  
SILICON NPN EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 電力増幅用
- 励振段電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- Driver Stage Amplifier Applications.
- ・ トランジション周波数が高い。:  $f_T = 100\text{MHz}$  (Typ.)
- ・ 2SA968とコンプリメンタリになります。
- ・ Can Type (TO-66)の2SC2239もあります。
- ・ Complementary to 2SA968.

## 最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース 間電圧	2SC2238	160	V
	2SC2238A	180	
	2SC2238B	200	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SC2238	160	V
	2SC2238A	180	
	2SC2238B	200	
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	1.5	A
エミッタ電流	$I_E$	-1.5	A
コレクタ損失 (Tc = 25°C)	$P_C$	25	W
接合温度	$T_j$	150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	°C

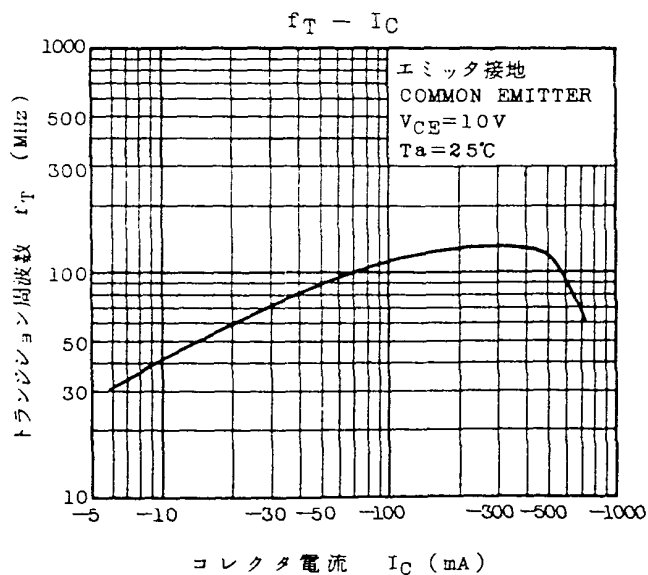
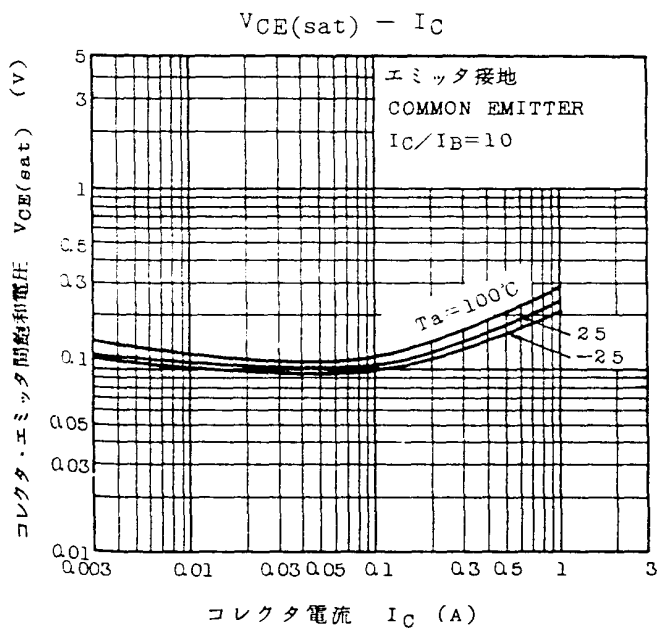
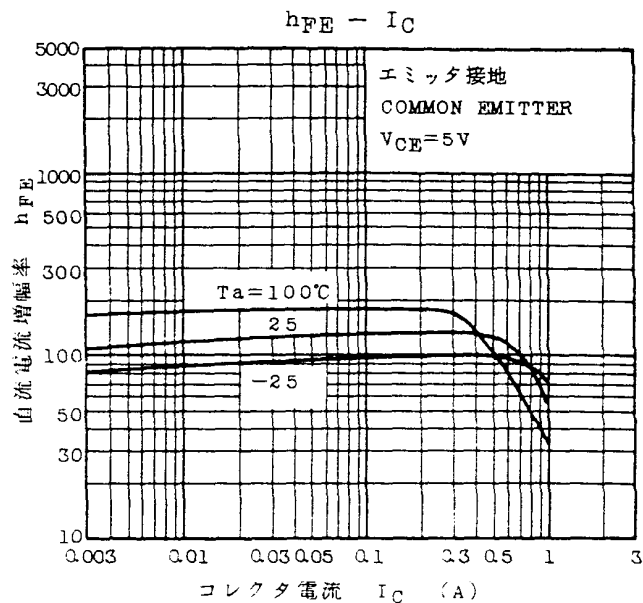
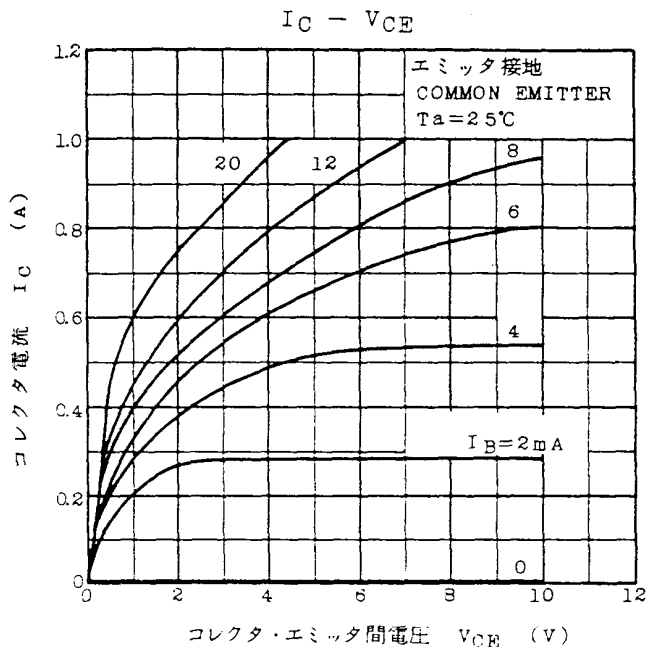


アクセサリはAC75を適用  
MOUNTING KIT No. AC75

## 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

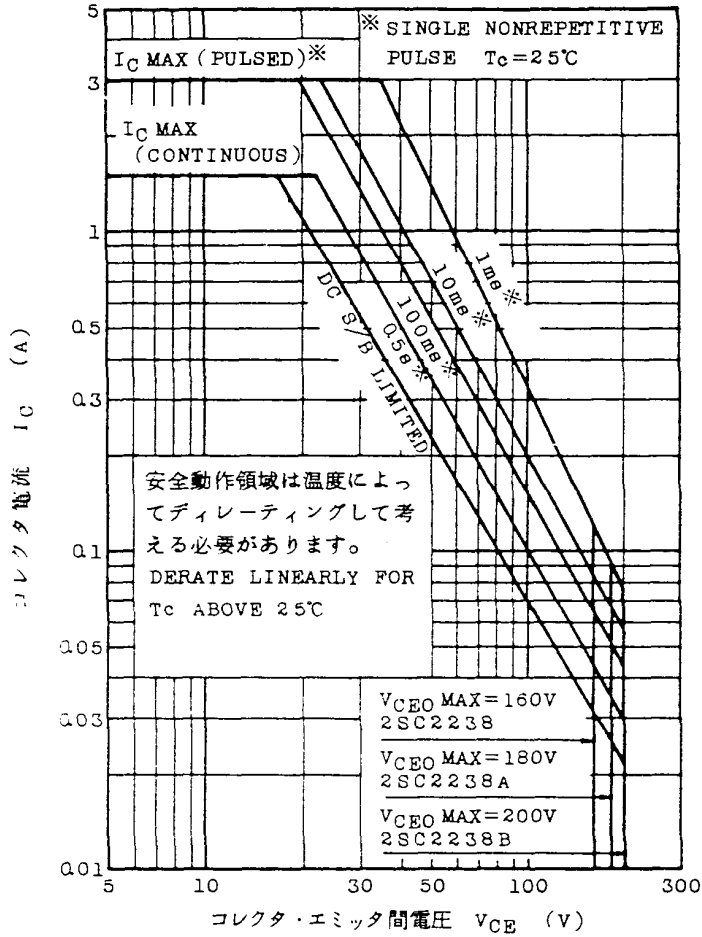
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゅ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 160\text{V}, I_E = 0$	-	-	1.0	$\mu\text{A}$
エミッタしゅ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5\text{V}, I_C = 0$	-	-	1.0	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	2SC2238	$I_C = 10\text{mA}, I_B = 0$	160	-	-	V
	2SC2238A		180	-	-	
	2SC2238B		200	-	-	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 1\text{mA}, I_C = 0$	5	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$ (Note)	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 100\text{mA}$	70	-	240	-
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 500\text{mA}, I_B = 50\text{mA}$	-	-	1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 500\text{mA}$	-	-	1.0	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = 10\text{V}, I_C = 100\text{mA}$	-	100	-	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = 10\text{V}, I_C = 0, f = 1\text{MHz}$	-	25	-	pF

# 2SC2238・2SC2238A 2SC2238B

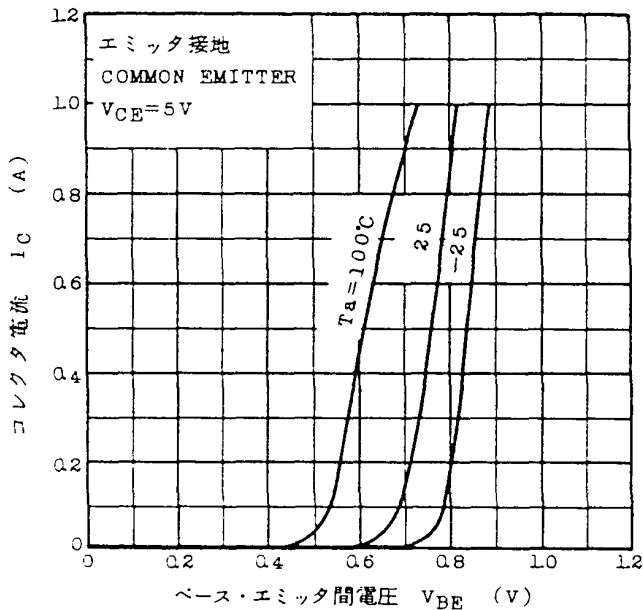


# 2SC2238・2SC2238A 2SC2238B

安全動作領域 ASO



$I_C - V_{BE}$



$P_C - T_a$

